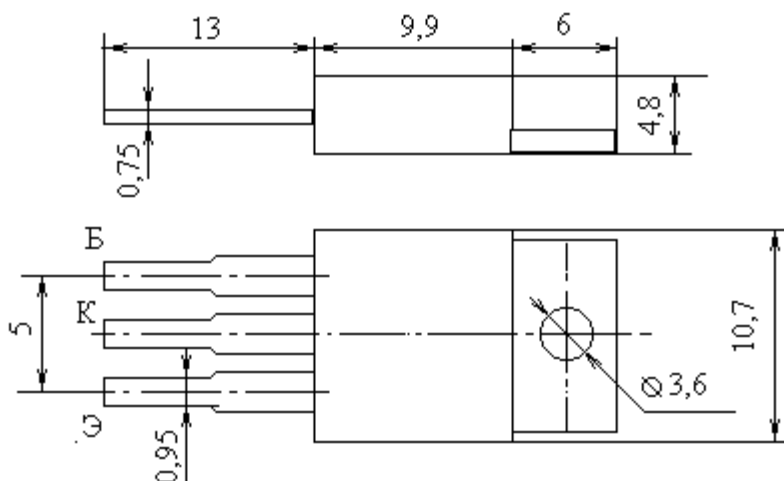


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ850Б
Материал	Si
$I_k \text{ max}, \text{A}$	2
$U_{кэо гр}(U_{кэо, и max})[U_{кэг max}], \text{В}$	{250}
$U_{кбо max}(U_{кбо, и max}), \text{В}$	300
$U_{эбо max}(U_{эбо, и max}), \text{В}$	5
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ср max})(P_k, и max), \text{Вт}$	25
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$	(100)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 \text{ тип}}]$	20...200
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{В}$	10
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{В}$	0.5
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, \text{mA}$	1
$f_{гр}(f_{h_{21}}), \text{МГц}$	0.5
$S_k, \text{пф}$	20
$S_э, \text{пф}$	35
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], \text{мкс}$	(2.7)